PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-263873

(43) Date of publication of application: 17.09.2002

(51)Int.CI.

B23K 26/00 B23K 26/06 B23K 26/14 H05K 3/00 // B23K101:42

(21)Application number: 2001-060591

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

05.03.2001

(72)Inventor: FUNEMI KOJI

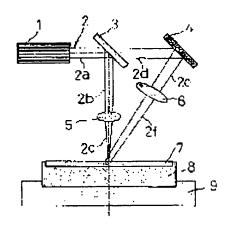
KASAI TAKAAKI

(54) METHOD AND DEVICE FOR LASER MACHINING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and device for laser machining capable of performing the laser machining with good productivity and at a low cost by efficiently removing a smear continually after forming a laser hole so as to prevent sticking of the smear to a workpiece.

SOLUTION: The laser hole is formed on workpiece 7 by irradiating with a first laser beam 2c, and the circumference of the laser hole is irradiated with a second laser beam 2f, the diameter of the irradiation spot of which is larger than the diameter of that of the first laser beam 2c and which has energy density lower than that at the irradiation spot in conjunction with the irradiation of the first laser beam 2c to remove the smear produced at machining the laser hole.



起枝(放加工物) …XYステージ(移転1段)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出處公開發号

特開2002-263873

(P2002-263873A)

(43)公開日 平成14年9月17日(2002.9.17)

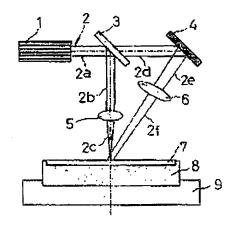
(51) Int.CL?	織別記号	FΙ	ラーマコード(参考)
B 2 3 K 26/00 26/00	3 3 0	B 2 3 K 26/00 26/06	330 4E068 C A E Z
	審查商泉	未商求 請求項の数11 〇	-
(21)出職番号	特顧2001-60591(P2001-60591)	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社	
(22)出驗日	平成13年3月5日(2001.3.5)	大阪府門真市大字門真1006番地 (72) 宛明者 船見 治司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内	
		(72)発明者 葛西 冬昭 大阪府門3 産業株式を	文市大字門真1006番地 松下電器
		(74)代理人 100080827 弁理士 7 ドターム(参考) 4E068	

(54) 【発明の名称】 レーザ加工方法およびレーザ加工装置

(57)【要約】

【課題】 レーザ穴形成と連続して効率良くスミア除去を行うことにより、被加工物へのスミア付着を防止し、 生産性が良く低コストでレーザ加工を行うことができる レーザ加工方法およびレーザ加工装置を提供する。

【解決手段】 第1レーザビーム2cの照射により被加工物7上にレーザ穴を形成し、照射スポットの径が第1レーザビーム2cの照射スポットの径より大径でかつ照射スポットでのエネルギ密度より低い第2レーザビーム2fを、第1レーザビーム2cの照射に連動して前記レーザ穴の周囲に照射することにより、レーザ穴加工時に発生するスミアを除去する。



1…レーザー発振器

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ発振器から出力されたレーザビー ムを、集光手段により集光して被加工物に照射すると共 に、前記レーザビームを前記被加工物上で相対的に移動 させることにより被加工物にレーザ加工を行うレーザ加 工方法において、第1レーザビームの照射により被加工 物にレーザ穴加工し、照射スポットの径が第1レーザビ ームの照射スポットの径より大径でかつ照射スポットで のエネルギ密度が第1レーザビームのエネルギ密度より 時にまたはその照射直後に前記レーザ穴の周囲に照射す ることにより、彼加工物にレーザ加工することを特徴と するレーザ加工方法。

【請求項2】 レーザ発振器から出力されたレーザビー ムを分岐手段により分岐させ、分岐させた一方のレーザ ビームを集光して第1レーザビームとすると共に、前記 **分岐させた他方のレーザビームを集光して第2レーザビ** ームとする請求項1記載のレーザ加工方法。

【請求項3】 第1レーザビームと第2レーザビーム を、それぞれ別なレーザ発振器から出力する請求項1記 20 戯のレーザ加工方法。

【請求項4】 レーザ発振器から出力されたレーザビー ムを、第1、第2レーザビームに適したスポット径でか つそれぞれの照射スポットで所定のエネルギ密度となる ように集光可能な集光手段を、レーザビームの光軸に主 軸をほぼ合わせて配置する調求項1記載のレーザ加工方 法。

【請求項5】 第2レーザビームのスポット径が、第1 レーザビームのスポット径に対し、同心円状に約3~5 倍である請求項1から4までの何れか1項に記載のレー 30 である。 ザ加工方法。

【請求項6】 第1レーザビームの照射スポットでのエ ネルギ密度が被加工物の加工閾値以上で、かつ第2レー ザビームの照射スポットでのエネルギ密度が前記加工闘 値以下となるように、各レーザビームのエネルギ密度分 布を調整する請求項1から5までの何れか1項に記載の レーザ加工方法。

【請求項?】 レーザビームは発続波長が400mm以 下の紫外領域であるレーザ発振器から出力されるもので あり、被加工物が樹脂材料のものである請求項1から6 40 いる。 までの何れか1項に記載のレーザ加工方法。

【語求項8】 レーザ穴加工により生じた付着物の付着 領域の径をまd、、第2レーザビームのスポット径をま d。 レーザビームの移動距離をSとしたときに、2S - ニュス - しかば照ばれたかては暗命ですかたりま

と、前記分岐された他方のレーザビームを、前記レーザ 穴の周囲に照射してレーザ穴加工時に生じた付着物を除 去する第2レーザビームとして集光する第2集光手段。 と、集光された第1、第2レーザビームを連動させつつ 前記被加工物上で相対的に移動させる移動手段とを備え たことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項1()】 レーザビームを出力するレーザ発録器 と、前記レーザビームを、被加工物に照射してレーザ穴 加工する第1レーザビームおよび前記レーザ穴の周囲に 低い第2 レーザビームを、第1 レーザビームの照射と同 10 照射してレーザ穴加工時に生じた付着物を除去する第2 レーザビームとして集光する集光手段と、集光された第 1. 第2 レーザビームを連動させつつ前記紋加工物上で 相対的に移動させる移動手段とを備え、前記集光手段は 第1集光レンズと第2集光レンズとで構成され、第1集 光レンズの径をゆD1、第2集光レンズの径をゆD2、 第2 集光レンズに入射されるレーザビームの径をゆりし としたときに、 **ΦD2>ΦDL>ΦD1の関係で、かつ** レーザビームの光軸と第1、第2集光レンズの主軸をほ ぼ合わせて配置したことを特徴とするレーザ加工装置。 【請求項11】 レーザビームは発振波長が400mm 以下の紫外領域であるレーザ発振器から出力されるもの であり、彼加工物が樹脂材料のものである請求項9また

【発明の詳細な説明】

は10記載のレーザ加工装置。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザビームによ って被加工物をレーザ加工するレーザ加工方法およびレ ーザ加工装置に関し、樹脂材料からなる回路基板などの 被加工物に微小径の穴開け加工を行うものに関するもの

[0002]

【従来の技術】近年の電子機器の高性能化に伴い 回路 基板の小型・軽量化が要求されている。このため回路基 板上のスルーホールまたはプラインドホールは、穴径の 微細化が必須とされ直径200μm以下とする必要が生 じている。このような微小径のレーザ穴加工により、穴 関け加工や切断加工などを行うのは、高エネルギを使用 した熱影響のない高品質なレーザ加工が行える発信波長 が400mm以下の紫外領域である紫外レーザが適して

【0003】しかしながら、ガラスエポキシ勧脂からな る回路基板や「ポリイミドからなる樹脂回路基板など、 炭素を多く含む核加工物に対してレーザビームを用いた レーザ穴形成により、例えば穴開け加工を行うと、回路 世紀市に今まれず)、を皇妻が北京結婚が(章章・元) / /+

はスミアもしくはデブリと呼ばれ、回路基板の絶縁特性 や導電特性などの電気的特性を悪化させるという問題が あった。

【0004】そとで従来では、スミアが付着した回路基 板に対しては、滅圧されたプラスマ雰囲気中に回路基板 全体を挿入し、回路基板の近傍で電界を発生させて基板 を帯電させて電荷を放出させることによって、分子学的 にスミアを除去していた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが上記従来の減 10 レーザ発録器から出力しても良い。 圧プラズマ方法では、プラズマ放電のために減圧可能な 真空処理装置が必要となる上、その処理プロセスはバッ チ処理となるので効率が悪く、連続処理を要する大量生 産には適さず、生産性が非常に悪いという問題がある。 またとの方法では、回路墓板の全面に対して処理を行う ために、その一部分のみを処理したいときでも、1枚の 基板と同じ処理時間や処理コストがかかるという問題も ある。

【①①①6】そこで本発明は上記問題点を解消し、レー が穴加工と連続して付着物であるスミアの除去を行うこ 20 できる。 とにより、彼伽工物へのスミア付着を防止し、生産性が 良く低コストで効率よくレーザ加工を行うことができる レーザ加工方法およびレーザ加工装置を提供することを 目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明のレーザ加工方法は、レーザ発振器から出力さ れたレーザビームを、集光手段により集光して被加工物 に照射すると共に、前記レーザビームを前記被加工物上 で相対的に移動させることにより被加工物にレーザ加工 30 を行うレーザ加工方法において、第1レーザビームの照 **射により彼加工物にレーザ穴加工し、照射スポットの径** が第1レーザビームの照射スポットの径より大径でかつ 照射スポットでのエネルギ密度が第1レーザビームのエ ネルギ密度より低い第2レーザビームを、第1レーザビ ームの照射と同時にまたはその照射直後に前記レーザ穴 の周囲に照射することにより、彼加工物にレーザ加工す ることを特徴とする。

【0008】このレーザ加工方法によれば、第1レーザ ビームの照射により被加工物にレーザ穴加工を行ったと 40 きに発生してレーザ穴周囲に付着したスミア(付着物) を、第2レーザビームを第1レーザビームの照射と同時 またはその照射直後にレーザ穴周囲に照射することによ り、レーザ穴開け加工やレーザ切断のためのレーザ穴加 十四治性に大統領自ノ路上やスピールがある。 光路体を向

るのでスミア付着領域をカバーできると共に、エネルギ 密度が低いので、彼加工物を加工してしまうことはな

【0009】上記レーザ加工方法において、レーザ発録 器から出力されたレーザビームを分岐手段により分岐さ せ、分岐させた一方のレーザビームを集光して第1レー ザビームとすると共に、前記分岐させた他方のレーザビ ームを集光して第2レーザビームとしても良いし、また 第1レーザビームと第2レーザビームを、それぞれ別な

【①①10】上記レーザ加工方法において、レーザ発振 器から出力されたレーザビームを、第1、第2レーザビ ームに適したスポット径でかつそれぞれの照射スポット で所定のエネルギ密度となるように集光可能な集光手段 を、レーザビームの光輪に主輪をほぼ合わせて配置すれ ば好適であり、非球面レンズ等を用いれば!枚の集光手 段でも、レーザ加工用の第1レーザビームとスミア除去 用の第2レーザビームを集光し照射でき、効率良くスミ アを除去でき、生産性の向上、コスト低減を図ることが

【① 0 1 1 】また上記各レーザ加工方法において、第2 レーザビームのスポット径が、第1レーザビームのスポ ット径に対し、同心円状に約3~5倍であると好適であ る。つまり、スミア付着領域が第1レーザビームのスポ ット径の約3倍であり、それが除去されるのは次のショ ット時の第2レーザビームの照射によることを考慮して おり、3倍以下であるとスミアが残ってしまうし、5倍 以上になるとエネルギ効率が悪くなるので、約4倍が最 適である。

【①①12】さらに上記各レーザ加工方法において、第 1レーザビームの照射スポットでのエネルギ密度が被加 工物の加工閾値以上で、かつ第2レーザビームの照射ス ポットでのエネルギ密度が前記加工関値以下となるよう に
呂レーザビームのエネルギ密度分布を調整したり、 レーザ穴加工により生じた付着物の付着領域の径をある s . 第2レーザビームのスポット径をφd . 、レーザビ ームの移動距離をSとしたときに、25くする2-する 。となる関係を有するように構成すると好適である。

【()() 13】上記目的を達成するために本発明の第1の レーザ加工装置は、レーザビームを出力するレーザ発振 器と、前記レーザビームを分岐する分岐手段と、分岐さ れた一方のレーザビームを、綾加工物に照射してレーザ 穴加工する第1レーザビームとして集光する第1集光手 段と「前記分岐された他方のレーザビームを、前記レー 表中の国内に召出しずし上去中国十年でキャルは称かれ

用の第1レーザビームとスミア除去用の第2レーザビー ムとを分岐手段により分岐させ、さらにそれぞれを集光 する第1集光手段と第2集光手段と、両レーザビームを 連続処理できる移動手段とを備えることにより、大がか りな真空処理装置等の別装置を必要とせずに、レーザ穴 加工により生じた付着物(スミア)の除去を連続して効 率良く除去することができ 生産性を向上することがで きると共に、スミア除去処理のために特別な処理時間や 処理コストがかからないので、その点においても生産性 良く、処理コストを低減することができる。

【①①15】上記目的を達成するために本発明の第2の レーザ加工装置は、レーザビームを出力するレーザ発録 器と、前記レーザビームを、被加工物に照射してレーザ **穴加工する第1レーザビームおよび前記レーザ穴の周囲** に照射してレーザ穴加工時に生じた付着物を除去する第 2レーザビームとして集光する集光手段と、集光された 第1. 第2 レーザビームを連動させつつ前記被加工物上 で相対的に移動させる移動手段とを備え、前記集光手段 は第1集光レンズと第2集光レンズとで構成され、第1 集光レンズの径をφD1、第2集光レンズの径をφD 2、第2集光レンズに入射されるレーザビームの径をあ Dしとしたときに、øD2>øDL>øD1の関係で、 かつレーザビームの光輪と第1、第2集光レンズの主軸 をほぼ合わせて配置したことを特徴とする。

【①①16】とのレーザ加工装置によれば、第1レーザ ビームとして、第1集光レンズと第2集光レンズとで集 光される中央部ではエネルギ密度が高くなる一方。第2 レーザビームとして、第1集光レンズの周囲の環状のレ ーザビームを第2集光レンズで集光される周囲では、第 1 レーザビームのスポット径より大径となりかつエネル ギ密度が低くなる。したがって、レーザビームの径と第 1 第2集光レンズの径を所定の配置関係となるよう装 置を設計するだけで、レーザ加工用の第1レーザビーム とスミア除去用の第2レーザビームを、移動手段により 相対移動させつつ連続して確実に照射でき、大がかりな 真空処理装置等の別装置を必要とせずに、レーザ穴加工 により生じた付着物(スミア)の除去を連続して効率良 く除去することができ、生産性を向上することができる と共に、スミア除去処理のために特別な処理時間や処理 コストがかからないので、その点においても生産性良 く、処理コストを低減することができる。

【0017】尚、上記各レーザ加工方法およびレーザ加 工装置は、レーザビームは発振波長が400mm以下の 紫外領域であるレーザ発振器から出力されるもので、彼 言し変え悠存まなうご うかおびじゅじゅょいい

して示した全体構成図である。1はレーザビーム2a (総称するときはレーザビーム2とする。)を出力する レーザ発振器。3はレーザビーム2を分岐させるハーフ ミラー (分岐手段)、4はハーフミラー3を透過したレ ーザビーム2 d を反射する全反射ミラー、5はハーフミ ラー3で反射されたレーザビーム2Dを集光し、第1レ ーザビーム2 c として制脂材料からなる回路基板(彼加 工物)7に照射する第1集光レンズ(第1集光手段)、 6は全反射ミラー4で反射されたレーザビーム2 eを集 19 光し、第2レーザビーム2 f として回路基板7に照射す る第2集光レンズ(第2集光季段)、8は回路基板7を 固定する基板ホルダー、9は基板ホルダー8を踏載して 所定の加工位置へ位置決めするXYステージ(移動手 段)である。尚、移動手段は、第1レーザビーム2cと 第2レーザビーム2 ! とを追動させつつ回路基板?上で 相対的に移動させるものであればこれに限定されない。 【0020】図1において、レーザ発振器1から出力さ れたレーザビーム2 a は、ハーフミラー3で2分岐され る。まず、ハーフミラー3で反射されたレーザビーム2 26 りは、第1集光レンズ5で集光され第1レーザビーム2 cとして回路基板7上に照射されることにより、回路基 板?にレーザ穴10(図2)を形成する。そして第1レ ーザビーム2cとXYステージ9との組対移動により、 レーザ穴10が連続加工され、回路墓板7に加工穴13 (図3 (a)) が穴関け加工される。レーザ加工にはこ のような穴関け加工のほか。プラインド加工、スクライ ビング加工などがある。

【①①21】一般に、樹脂材料に対して、熱影響のない 高品質なレーザ加工を行う場合、波長が約400mm以 下の繁外レーザを用いてレーザ穴加工を行っている。ま た紫外レーザは、回路基板の厚みが100μm以下の微 細加工を行う場合にも用いられている。その際に問題と なるのが、紫外レーザでレーザ加工を行ったときに、樹 脂材料から発生するスミアが、その加工部の周囲に付着 することである。これは、樹脂材料中に含まれている炭 素が昇華、もしくは蒸発して、ダストとして空気中に放 出されて空気中で冷却され、回路基板の加工穴等の周囲 に付着したものである。具体的には、回路基板の表面や スルーホール加工された墓板の裏面、穴内部、ブライン 40 下加工された穴の底部に付着する。付着したダストはス ミアもしくはデブリと呼ばれる。

【① ①22】図2(a)は、上記機成のレーザ加工装置 を用いたレーザ加工方法により、具体的には第1レーザ ビーム2cの照射によりそのスポット径と同じゆ20μ war に最合しの相子が行ったしまた。 しょぞぞしのの スミアは、非常に小さい微紛末であり、回路基板上に軽 く積層されているだけである。そのため、そのスミア付 者領域11にレーザビーム2を照射すると、その照射ス ポットにおいて非常に低いエネルギ密度でも、スミアを 蒸発・除去することができる。尚、エネルギ密度を低く 設定すると回路基板上を加工してしまうことはない。

【①023】第1実施例では、このスミア除去として第 2レーザビーム21を用いる。この第2レーザビーム2 flは、ハーフミラー3を透過したレーザビーム2 dを全 より集光して回路基板7上のレーザ穴10の周囲に照射 される。第2レーザビーム28の照射スポットの径は図 2 (b) に示すように、第1レーザビーム2cのスポッ ト径 (レーザ穴径) Φ20 μmの約4倍のΦ80 μmと 設定され、照射面論もそれと同じになる。これは後述す るように、2ショット目の第2レーザビーム2fが1シ ョット目の第1レーザビーム2cの照射により付着した スミア (スミア付着領域11はΦ60μm)をカバーで きる範囲に設定している。また照射スポットでのエネル ギ密度は、スミアを蒸発・除去するのに必要なエネルギ 20 エネルギ(1μJ)を、照射しなければならない。 密度以上、つまり後述するエネルギ密度分布での加工闘 値以上で、かつ回路基板?に対しては加工されない加工 関値以下に設定している。そのため、図2 (c) に示す ように、スミアだけを綺麗に除去することができる。

尚。回路基板?が少し程度なら加工されてもよい場合に は、生産性向上のため、前記加工関値以上に第2レーザ ビーム2 fのエネルギ密度を高く設定してスミアを除去 してもよい。

【①①24】次に、レーザ加工のうち穴開け加工を1字 例として挙げて具体的に説明する。

【①①25】レーゲ加工装置の構成は図1で示した構成 と同じであるので、同図を用いて同符号により説明す る。レーザ発振器1としては、Na:YAGレーザ発続 器の第3次高調波を使用する。そのときの発振波長は、 紫外領域の355nmである。更に、音響光学素子を用 いて変調をかけてパルス状にレーザ発振を行う。このレ ーザ発振器1から出力されたレーザビーム2aは、ハー フミラー3でその前記出力の約半分のレーザビーム2 b だけ反射され、残り半分のレーザビーム2 d は透過す る。反射されたレーザビーム2りは、第1集光レンズ5 でスポット径φ20μmに集光される。本字例では、回 路基板7として、厚み50 µ mのポリイミド樹脂を使用 している。

【①①26】レーザ発振器1から出力されるレーザビー) りゃみだっちゃんと、同時世紀でき代表によい、2 VV することができる。

【0027】そのときのレーザ穴10加工とそれを用い た加工穴13の穴関け加工の工程を、図3(a)~ (d)に順に示す。図3(a)は、第1レーザビーム2 cを1ショット照射したときのレーザ穴10を示してい る。同図において、矢印は、XYステージ9の動作を示 している。図3 (b)は、XYステージ9が1/2周し た後のレーザ穴 10の連続加工状況を示している。図3 (c)は、XYステージ9が1周した後のレーザ穴10 反射ミラー4により反射し、さらに第2集光レンズ6に 10 の連続加工状況を示し、中央部の円形状のカス12が抜 け落ちる直前の状態である。そして、そのカス12が抜 け落ちた結果。図3 (d) に示すように、ゆ200µm の加工穴13の穴関け加工が完了する。その完了と共 に、XYステージ9の移動。レーザ発振器1の出力も完 了する。本専側では、1パルス当たりのエネルギ50 μ Jで、1周で加工穴13の穴関け加工を行っているが、 1パルス当たりのエネルギをもっと下げて、何圏かで、 前記穴開け加工を行ってもよい。ただし最低限でも、回 路墓板?であるポリイミド墓板が加工されるのに必要な

8

【0028】一方、ハーフミラー3を透過してきたレー ザビーム2 dは、全反射ミラー4で反射された後に第2 集光レンズ6で集束されて、第2レーザビーム21とし てレーザ穴10の周囲に照射される。従って、第2レー ザビーム2 fの照射範囲14 (図2(b))は、レーザ 穴10の周囲に付着するスミア付着領域11よりも大き くなる。

【()()29】第1実施例では、第1レーザビーム2cの 1ショットでのスミア付着領域11は約Φ60μmであ った。そのため、スミア除去用のレーザ照射範囲14つ まり第2レーザビーム21のスポット径は、図2(り) に示すようにゆ80μmとした。レーザ穴10(第1レ ーザビーム2cのスポット径)、スミア付着領域11、 スミア除去用のレーザ照射範圍14 (第2 レーザビーム 2 f のスポット径)との3 者関係は図2(り)で明らか であり、また、XYステージ9の移動中の各部分の関係 は後述する図4(a)~(c)で明らかである。

【①①3①】尚、実際には、穴関け加工用の第1レーザ ビーム2 c とスミア除去用の第2 レーザビーム2 f が同 時に照射されている。ところが、回路基板でにスミアが 付着するのは、第1レーザビーム2cが照射された後で あり、当然、第2レーザビーム2十が照射された後であ る。つまり、図4(a)に示すように、1ショット目の 第1レーザビーム2cでレーザ穴10を形成し、その形 品味が熟光(もっさつ)4、 麻木 ノドンが二分 ドスパーの

ーザ穴10が第1レーザビーム2cにより形成され、同 時にスミアが発生して回路基板7に付着する。3 ショッ ト目も、それと同様である。このようにして、レーザ穴 10の加工時に発生するスミアは、XYステージ9の移 動に伴い次のレーザ穴加工時に順に除去されていく。

【① 031】上記事例では、1台のレーザ発振器1から レーザビーム2を分岐して、レーザ穴10の形成とスミ ア除去の両方に使用していたが、必ずしも、1台のレー が発振器1で行う必要はなく、2台以上を用いて行って

【0032】またスミア付着領域11の範囲は、最大で もレーザ穴10の径の3倍であるため、スミア除去用の レーザ照射範囲 14 (第2レーザビーム2 f のスポット 径) は、レーザ穴10(第1レーザビーム2cのスポッ ト径)の約4倍に設定している。またスミア付着領域1 1の径をます。 第2レーザビーム21のスポット径を Φd₂、第1. 第2レーザビーム2 c. 2 f の移動距離 をSとしたときに、2S<od、od。となる関係を 有するように構成すると好趣である。

[0033]次に本発明の第2実施例について、図5~ 29 図8を参照して具体的に説明する。

【0034】図5は第2実施例のレーザ加工装置を機略 して示した全体構成図である。尚、図1に示した第1寒 施例と同様の部分については同符号を付して説明する。 1はレーザビーム2a(総称するときはレーザビーム2 とする。)を出力するレーザ発振器、4はレーザビーム 2 a を反射する全反射ミラー、8 は回路基板7を固定す る墓板ホルダー、9は基板ホルダー8を搭載して所定の 加工位置への位置決めするXYステージ(移動手段)で

【①①35】15と16は全反射ミラーで反射されたレ ーザビーム2gの下流側に向けてレーザビーム2gの光 輪に主輪をほぼ合わせて順に配置される第1集光レン ズ、第2集光レンズである。第2実施例では、第1集光 レンズ15の径は、第2集光レンズ16の径よりも小さ く設定され、図5で示せば、第1集光レンズ15が第2 集光レンズ16よりも上方つまりレーザ発振器1に近 く、第2集光レンズ16が回路基板?に近く配置されて いる。

【0036】との2種類の第1集光レンズ15と第2集 40 光レンズ16とレーザビーム2との関係を図6に示す。 図6において、第2集光レンズ16へのレーザビーム2 gのレーザビーム径をゅDしとし、第1集光レンズ15 のレンズ径をΦD1とし、第2集光レンズ16のレンズ 仅もよりのしずるし 合り事格闘がゆ

1 集光レンズ15の国間の環状のレーザビーム2 i (Φ D1以上、 aD1以下のレーザビーム成分) は、第1集 光レンズ15で集光されないでそのまま通過して第2集 光レンズ16で集光され、回路基板7のレーザ穴10周 **開に昭射されるレーザビーム2 j (これがダスト除去用** の第2レーザビームであるので以下。第2レーザビーム 2」とする。)となる。

【①038】一方、レーザピーム2hは第1集光レンズ 15で集光されて21となり、更に第2集光レンズ16 19 で集光され、回路基板7に照射されてレーザビーム2 k となる。この2種類のレンズを通ってきたレーザビーム 2k(これがレーザ穴加工用の第1レーザビームである ので以下、第1レーザビーム2kとする。)が集光する 照射スポット位置に、彼加工物である回路基板?を位置 決め設定しておく。

【①①39】第2実施例のレーザ穴の形成時のスミア付 者領域11とスミア除去用のレーザ照射範囲14は、第 1.実能例と同様であるので、図2の(a)~(b)を参 騒する。

【① ①4 ①】第1レーザビーム2kのスポット径は約ま 20μmとなり、レーザ穴10の径も同じとなる。そし てその周囲の約φ60 mmのスミア付着領域11にスミ アが付着していた。また、第1集光レンズ15で集光さ れないでそのまま通過して第2集光レンズ16で集光さ れた第2レーザビーム2」のスポット径(レーザ照射範 盥14)は、スミア付着領域11よりも大きく約φ80 μωとなる。こうした大きさの関係となるように、第1 集光レンズ15と第2集光レンズ16およびその配置を あらかじめ設計しておく。

【①①41】また回路基板?上の照射スポットでのエネ 30 ルギ密度分布を図りと図8に示す。図りでは、その中央 部の円内が、2種類の集光レンズ(第1集光レンズ15 と第2集光レンズ16)を通過してきた第1レーザビー ム2kで照射されるレーザ穴加工用のレーザ照射範囲! 7で、約φ20μmである。外側の円内が、第2集光レ ンズ16のみを通過してきた第2レーザビーム21で照 崩されるスミア除去用のレーザ照射範囲14で、約48 Qμmである。図8は、図7をA-A線で断面した状態 で昭射スポットでのエネルギ密度分布を表している。図 8から分かるように、中央部のレーザ照射範囲17でエ ネルギ密度が高く、その周囲のレーザ照射範囲 14で低 くなっている。また、この分布図において、1点鎖線B -B線が、回路基板?の創工閾値であり、2点鎖線C-C線が、スミア除去のための加工閾値である。つまり、 出来到了!… 主要なな国ニュンコ語 単語 さんぞくじん

特開2002-263873

エネルギ密度分布を満足するような集光手段を設計すれ はよい。また、非球面レンズなどを用いれば、1枚の集 光レンズでもそれを実現できる。

11

【① 0.4.3】尚、上記各実施例では、穴開け加工を取り上げたが、レーザ穴の形成によりレーザ加工を行うものであれば、それ以外に、ブラインド加工、スクライブ加工、切断加工などのレーザ加工一般に対して適用可能である。

[0044]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、第 1レーザビームによる被加工物上へのレーザ穴加工と連 続して、そのときに生じた付着物(スミア)を、第2レ ーザビームの照射により効率良く除去することにより、 被加工物へのスミア付者を防止し、生産性が良く低コス トでレーザ加工を行うことができるレーザ加工方法およ びレーザ加工装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1 実施例の全体構成を示す機断側面図。

【図2】 本発明の実施例におけるレーザ穴加工時のスミ 20 ア付着領域とレーザ照射範囲を示す平面図。

【図3】本発明の第1実施例におけるレーザ穴加工とそれを用いた穴開け加工の工程を順に示す平面図。

【図4】同葉能倒におけるレーザ穴加工およびスミア除*

* 去を連続して示す平面図。

【図5】本発明の第2 実施例の全体構成を示す機断側面図。

12

【図6】同実施例における集光手段とレーザビームとの 関係を示す縦断側面図。

【図?】同実能例におけるレーザビームの照射範囲とその照射スポットでのエネルギ密度を示す平面図。

【図8】図7をA-A線で断面した状態でエネルギ密度 分布を示す断面図。

【符号の説明】

- 1 レーザ発振器
- 2 レーザビーム
- 2c. 2k 第1レーザビーム
- 21.2) 第2レーザビーム
- 3 ハーフミラー(分岐手段)
- 5. 15 第1集光レンズ (集光手段)
- 6. 16 第2集光レンズ (集光手段)
- 7 回路基板(被加工物)
- 9 XYステージ(移動手段)
-) 10 レーザ穴
 - 11 スミア付着領域
 - 13 加工穴
 - 14 スミア除去用のレーザ照射範囲
 - 17 レーザ穴形成用のレーザ照射範囲

特開2002-263873 (8) [図6] [図3] [図5] DL (9) (b) (c) 12 [図8] (d) 13 13…加工六 A-A種断節のエネルギ密究 [図7] フロントページの続き

識別記号

(51) Int.Cl.'

F !

テーマコード(参考)

JAPANESE [JP,2002-263873,A]

CLAIMS DETAILED DESCRIPTION TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS DESCRIPTION OF DRAWINGS DRAWINGS

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] While condensing with a condensing means and irradiating at a workpiece the laser beam outputted from the laser oscillation machine In the laser-beam-machining approach of performing laser beam machining to a workpiece by moving said laser beam relatively on said workpiece Laser hole processing is carried out by the exposure of the 1st laser beam at a workpiece. The path of an exposure spot by the major diameter from the path of the exposure spot of the 1st laser beam and the 2nd laser beam with the energy density lower than the energy density of the 1st laser beam in an exposure spot the exposure of the 1st laser beam -- simultaneously -- or the laser-beam-machining approach characterized by carrying out laser beam machining to a workpiece by irradiating the perimeter of said laser hole immediately after the exposure.

[Claim 2] The laser-beam-machining approach according to claim 1 which condenses the laser beam of said branched another side, and is made into the 2nd laser beam while a laser beam is condensed and while the laser beam outputted from the laser oscillation machine was branched with the branching means and it was made to branch considers as the 1st laser beam.

[Claim 3] The laser-beam-machining approach according to claim 1 which outputs the 1st laser beam and the 2nd laser beam from a respectively different laser oscillation machine.

[Claim 4] The laser-beam-machining approach according to claim 1 which is a diameter of a spot suitable for the 1st and 2nd laser beam, and sets a main shaft mostly and arranges the condensing means which can condense to the optical axis of a laser beam for the laser beam outputted from the laser oscillation machine so that it may become an energy density predetermined at each exposure spot.

[Claim 5] The laser-beam-machining approach given in any 1 term to claims 1-4 whose diameters of a spot of the 2nd laser beam are about three to 5 times to the diameter of a spot of the 1st laser beam concentric circular.

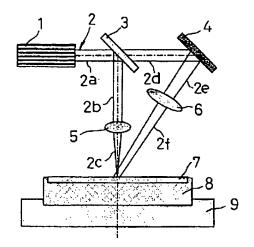
[Claim 6] The laser-beam-machining approach given in any 1 term to claims 1-5 which adjust the energy density distribution of each laser beam so that the energy density in the exposure spot of the 1st laser beam may be beyond the processing threshold of a workpiece and the energy density in the exposure spot of the 2nd laser beam may become said below processing threshold.

[Claim 7] A laser beam is the laser-beam-machining approach given in any 1 term to claims 1-6 whose workpieces it is outputted from the laser oscillation machine whose oscillation wavelength is an ultraviolet region 400nm or less, and are the things of a resin ingredient.

[Claim 8] When migration length of phid2 and a laser beam is set [the path of the adhesion field of the affix produced by laser hole processing] to S for phidS and the diameter of a spot of the 2nd laser beam, it is 2 S<phi d2-phidS. The laser-processing approach given in any 1 term to claims 1-7 which have unrelated relation.

[Claim 9]

Drawing selection Representative drawing 🛨



- 1…レーザー発振器
- 2 c…第1レーザービーム
- 2 f …第 2 レーザーピーム
- 3…ハーフミラー(分岐手段)
- 5…第1集光レンズ (集光手段)
- 6…第2集光レンズ (集光手段)
- 7…回路基板(被加工物)
- 9…XYステージ (移動手段)

[Translation done.]

JAPANESE [JP,2002-263873,A]

CLAIMS DETAILED DESCRIPTION TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS DESCRIPTION OF DRAWINGS DRAWINGS

[Translation done.]